

## 三星全新半導體研發中心樹立重大里程碑

三星舉辦 NRD-K 移機典禮，預計於 2025 年正式啟用

三星計劃於 2030 年前挹注 20 兆韓元，力挺先進半導體研發

三星電子日前於器興園區的新半導體研發中心 ( NRD-K ) 舉辦移機典禮，象徵邁向未來的重大里程碑。包括供應商和客戶在內約 100 名來賓應邀出席，共同慶祝此意義非凡的時刻。

作為先進科研機構，NRD-K 自 2022 年動工，預計將成為三星在記憶體、系統半導體和晶圓半導體研發領域的重要研究基地。憑藉其先進的基礎架構，NRD-K 將能實現研發與產品驗證的同廠作業。三星計劃在 2030 年前投入約 20 兆韓元，於器興園區內興建佔地約 109,000 平方公尺 ( m<sup>2</sup> ) 的 NRD-K 研發中心。該中心亦設有研發專用生產線，擬於 2025 年中旬正式啟用。





▲ 三星電子副會長暨裝置解決方案（DS）事業群負責人全永鉉於韓國器興新半導體研發中心（NRD-K）的移機典禮上發表演說。

三星電子副會長暨裝置解決方案（DS）事業群負責人全永鉉表示：「NRD-K 將全力推動研發，助力三星打造良性循環，加速新世代技術的基礎研究與量產製程。器興是三星電子 50 年半導體歷史的起點，我們將在此奠定未來發展的堅實基礎，創造下一個百年輝煌榮景。」

韓國應用材料（Applied Materials）公司負責人 Park Gwang-Sun 指出：「現階段，建立雙贏的合作關係比過往任何時候都更加重要。我們正致力於加速創新步伐，透過與三星電子密切合作，攜手推動半導體產業的新一波成長。」



▲ 三星電子副會長全永鉉（中）於器興園區的移機典禮與高階主管合影留念。\*（左起）人才團隊負責人 Wanwoo Choi、資安長 Taeyang Yoon、NRD-K P/J 小組負責人 Jiwoon Im、晶圓代工事業部負責人 Siyoung Choi、DRAM 製程開發團隊 BongHyun Kim、記憶體事業部負責人 Jung-Bae Lee、副會長暨裝置解決方案（DS）事業群負責人全永鉉、系統半導體事業部負責人 Yong In Park、快閃記憶體製程發展團隊 Yujin Lee、企業總裁暨半導體晶圓廠（FAB）工程與運作負責人 Seok Woo Nam、裝置解決方案技術長 Jaihyuk Song、企業辦公室負責人 HongGyeong Kim。

三星器興園區座落於首爾南部。1992 年，世界首款 64 MB DRAM 於此誕生，確立了三星日後躍升為半導體龍頭的基礎。新研發機構的落成將延續園區的卓越底蘊，專注於製程技術與製造工具的最新進展，持續引領創新潮流。



▲ 三星電子高階主管於器興園區的移機典禮上合影留念。

NRD-K 將配備高數值孔徑極紫外光微影技術和新型材料沉積設備，致力於加速新世代半導體記憶體的發展，如 3D DRAM 和超過 1,000 層的 V-NAND。此外，創新的晶圓對晶圓鍵合技術也計劃用於晶圓鍵合基礎架構之中。

三星今年於第三季投入 8.87 兆韓元的研發資金，創下歷史新高，並持續突破技術極限，力求在未來科技領域保持競爭優勢，如高頻寬記憶體（HBM）製程的先進封裝技術。